



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**H3619**

对应国外型号  
2SC3619

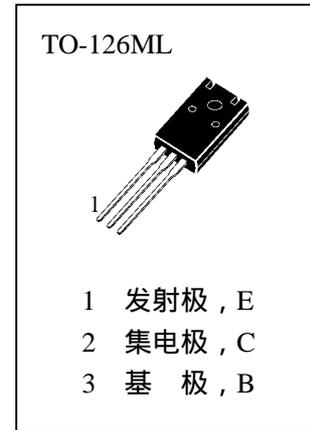
**主要用途**

高压开关放大

**极限值** ( $T_a=25$  )

$T_{stg}$ ——贮存温度.....	-55~150
$T_j$ ——结温.....	150
$P_C$ ——集电极耗散功率 ( $T_c=25$ ) .....	1.5W
$V_{CB0}$ ——集电极—基极电压.....	300V
$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压.....	300V
$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压.....	7V
$I_C$ ——集电极电流.....	100mA
$I_B$ ——基极电流.....	50mA

**外形图及引脚排列**



**电参数** ( $T_a=25$  )

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
$I_{CB0}$	集电极—基极截止电流			1.0	$\mu A$	$V_{CB}=240V, I_E=0$
$I_{EB0}$	发射极—基极截止电流			1.0	$\mu A$	$V_{EB}=7V, I_C=0$
$h_{FE}(1)$	直流电流增益	20				$V_{CE}=10V, I_C=4mA$
$h_{FE}(2)$		30		200		$V_{CE}=10V, I_C=20mA$
$V_{CE}(sat)$	集电极—发射极饱和电压			1.0	V	$I_C=10mA, I_B=1mA$
$V_{BE}(sat)$	基极—发射极饱和电压			1.0	V	$I_C=10mA, I_B=1mA$
$f_T$	特征频率	50			MHz	$V_{CE}=10V, I_C=20mA$
$C_{ob}$	输出电容		30		pF	$V_{CB}=20V, I_E=0, f=1MHz$